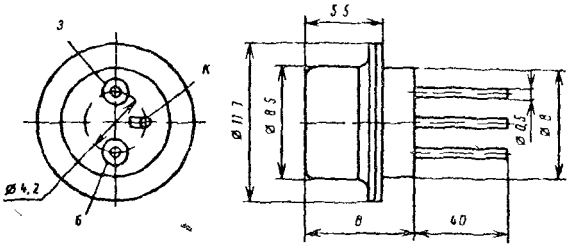
КТ605 (А, Б), КТ605 (АМ, БМ)

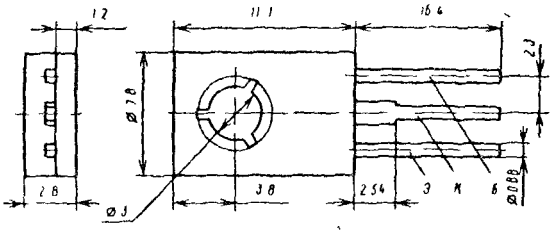
Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *n-p-n*. Предназначены для применения в усилителях, импульсных и переключающих высокочастотных устройствах. Выпускаются в металлостеклянном (КТ605А, КТ605Б) с гибкими выводами и пластмассовом (КТ605АМ, КТ605БМ) корпусах с жесткими выводами Тип прибора указывается на корпусе

Масса транзистора в металлостеклянном корпусе не более 2 г, в пластмассовом — не более 1 г.

КТ605 (А Б)



КТ605 (АМ БМ)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $I_Э=20$ мА, $U_{КЭ}=40$ В:	
КТ605А, КТ605АМ	10 40
КТ605Б, КТ605БМ	30 120
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КЭ}=40$ В, $I_Э=20$ мА, не менее	40 МГц
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_К=20$ мА, $I_Б=2$ мА, не более	8 В
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБО}=40$ В, $f=2$ МГц, не более	7 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБО}=0$ В, $f=2$ МГц, не более	50 пФ
Обратный ток коллектор — эмиттер при $U_{КЭ}=250$ В, не более	20 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБО}=5$ В, не более	50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база:	
при $T=+100$ °С	300 В
при $T=+150$ °С	150 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{бэ}=1$ кОм.	
при $T=+100$ °С	250 В
при $T=+150$ °С	125 В
Постоянное напряжение эмиттер — база:	
при $T=+100$ °С	5 В
при $T=+150$ °С	2,5 В
Постоянный ток коллектора	100 мА
Импульсный ток коллектора	200 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:	
при $T=+25$ °С	0,4 Вт
при $T=+100$ °С	0,17 Вт
Тепловое сопротивление переход — среда	300 °С/Вт
Температура *p-n* перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	−40...+150 °С

Изгиб выводов допускается под углом не более 90° в плоскости, перпендикулярной плоскости основания корпуса, и не ближе 3 мм от корпуса с радиусом изгиба не менее 1,5 мм.

При установке транзистора на печатную плату с шагом координатной сетки 2,5 мм допускается одноразовая формовка выводов с их разводкой для совмещения с монтажными отверстиями (контактами).

При изгибе и формовке выводов необходимо применять специальные шаблоны, а также обеспечивать неподвижность выводов между местом изгиба и корпусом транзистора. Кручение выводов вокруг оси не допускается.

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора в течение не более 5 с. Температура паяльника не должна превышать +260 °С. При пайке должен быть обеспечен надежный теплоотвод между местом пайки и корпусом транзистора.